

单位: mil

## LQBE45A

### 产品特性:

芯片尺寸: 45mil x 45mil  
(1160±50μm x 1160±50μm)  
芯片厚度: 6mil(150±20μm)  
焊盘尺寸: P焊盘:19milx43mil  
(485±30μm x 1085±50μm)  
N焊盘:35milx44mil  
(485±30μm x 1120±50μm)

焊盘金属

P焊盘: AuSn

N焊盘: AuSn



LatticePower

## 产品介绍

Product Introduction

# LQBE45A



LatticePower

## 产品介绍

Product Introduction

# LQBE45A

## 最大额定值

DC 正向电流	1000mA
正向峰值电流(1/10占空比@1kHz)	1500mA
LED结温	115℃
反向电压	5V
使用温度范围	-40 ~ 85℃
贮存温度范围	0 ~ 40℃

### 说明:

- 最大额定值为晶能光电封装条件下测试得到, 不同封装形式得到的值会有所不同, 建议在不超过最大额定值的条件下使用, 超过最大额定值使用可能会引起LED芯片损坏。
- 本产品非设计与逆向电流(压)下使用, 不建议在任何逆向电流(压)下使用。

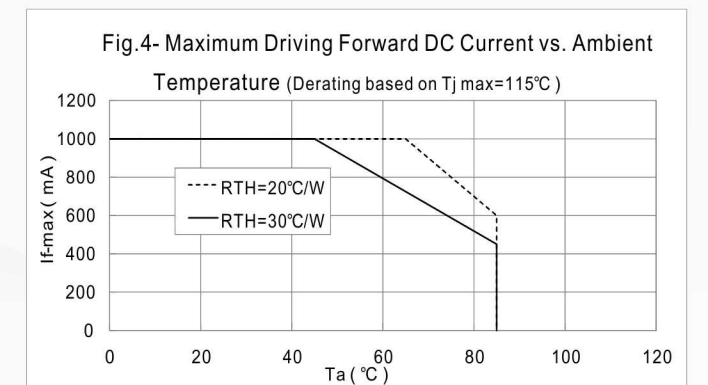
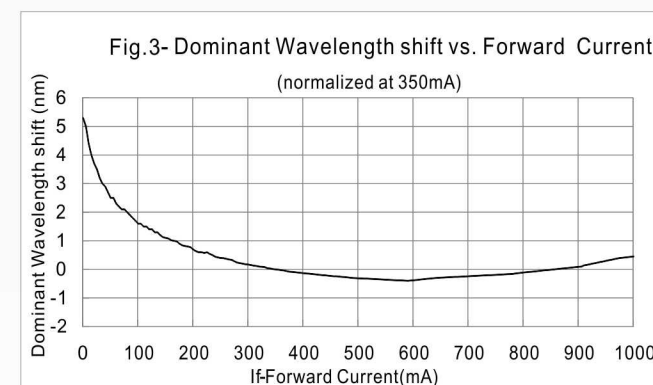
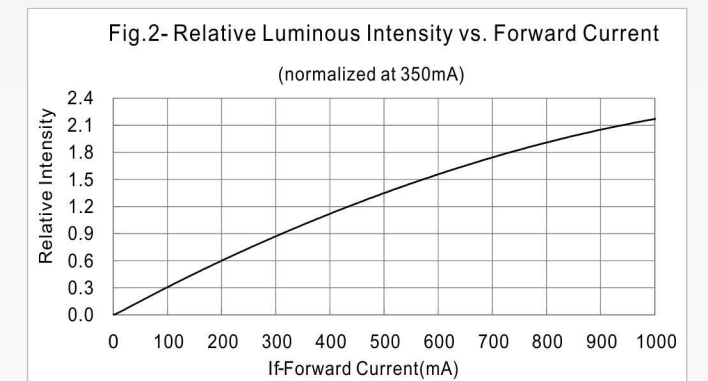
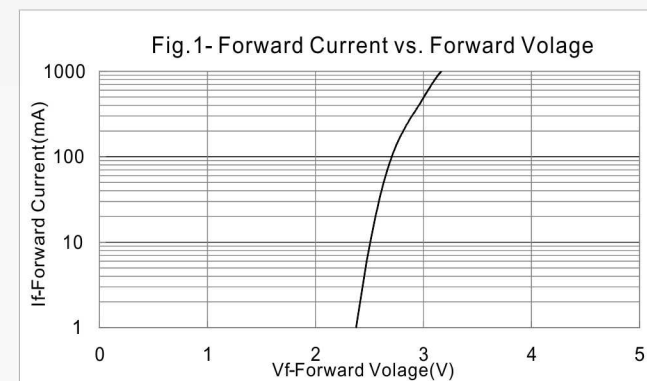
## 光电参数

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
开启电压	Vf1	If=10μA	2.0	---	2.8	V
工作电压	Vf2	If=350mA	2.8	---	3.6	V
反向漏电流	IR	Vr=5V	---	---	2	μA
主波长	λd	If=350mA	445	---	475	nm
半波宽度	Δλ	If=350mA	---	---	30	nm
光强	Po	If=350mA	425	---	600	mW

## 参数等级:

Po(mW)	Wd(nm)	447.5-450	450-452.5	452.5-455	455-457.5	457.5-460	460-462.5
575-600	FBHS	GAHS	GBHS	HAHS	HBHS	IAHS	
550-575	FBGS	GAGS	GBGS	HAGS	HBGS	IAGS	
525-550	FBFS	GAFS	GBFS	HAFS	HBFS	IAFS	
500-525	FBES	GAES	GBES	HAES	HBES	IAES	
475-500	FBDS	GADS	GBDS	HADS	HBDS	IADS	
450-475	FBCS	GACS	GBCS	HACS	HBCS	IACS	

## 特性曲线



### 其它说明:

- 光电参数为采用晶能光电测试仪器在室温下(TA=25℃)测试结果;
- GaN芯片为静电敏感产品, 请在使用、运输时注意静电保护;
- 可根据客户要求订做特殊规格芯片;

LatticePower

LatticePower